

RFMD ニュース

会社連絡先:

RF Micro Devices Inc.
Brian K. Cockman, Public Relations Specialist
7628 Thorndike Road
Greensboro, NC 27409-9421, USA
電話: +1 (336) 678-8945
bcockman@rfmd.com



RFMD 社が 48V 動作の GaN パワートランジスタシリーズを発表

出力／帯域幅／効率の組み合わせが特に優れた GaN デバイスの新シリーズ

ハワイ州ホノルル、2007年6月 14日 (IEEE MTT-S): 移動通信駆動用各種アプリケーション向け高性能無線システム/ソリューションの設計、製造で世界をリードするRFMD社(ナスダック:RFMD)は本日、窒化ガリウム(GaN)パワートランジスタRF393Xシリーズを発売すると発表した。RF393Xシリーズの出力範囲は10W~120Wで、同調可能な帯域幅が極めて広いことが特長。競合するGaAsデバイスやシリコンLDMOSデバイスと比較しても、出力と帯域幅を組み合わせたGaN技術の総合的な優位性が実証されている。

RFMD社のRF393Xファミリーを構成するのは48V動作で非整合のGaNパワートランジスタ5品種で、利得は14dB~16dBで最大ドレイン効率は2.1GHzで65%を超えている。RFMD社の高性能GaNパワートランジスタは広帯域特性や高効率が必要されるテレビ放送や無線インフラ、大電力レーダー、航空・宇宙関連のアプリケーションに適している。RFMD社ではGaN大電力半導体の想定可能な市場規模を約10億ドルと推定しており、そのうち非整合タイプのGaNパワートランジスタの市場は約1.5億ドルにのぼるといふ。同社では複数の市場でトップレベルの企業と関わっており、2007年の後半に生産を開始する見込み。

RFMD社の社長兼CEOのボブ・ブラッグワースが語る。「当社は10億ドルの大電力半導体市場で大きなシェアを確保できる位置にいます。当社は無線システム向け半導体の世界で顧客との関係が特に良好で、また化合物半導体を製造する業界リーダーであるだけでなく、携帯端末用パワーアンプでは世界最大のメーカーです。このような強みを生かし、当社はGaN製品のラインアップを拡大しつつ様々な高成長市場で新たな成長の機会を追求していきます。」

RFMD 社が開発中の高電圧 GaN シリーズには GaN パワートランジスタ、GaN RF IC、および整合タイプ GaN トランジスタの 3 種類の製品がある。高出力 GaN RFIC はマルチオクターブ帯域で高い効率が得られる完全整合型の高出力アンプで、軍用通信や業務用移動無線、ソフトウェア無線機(SDR)等のアプリケーションに適している。また内部整合タイプの高出力 GaN トランジスタにはインピーダンス特性と効率を改善するための整合素子が内蔵されており、大電力レーダーや WCDMA、WiMAX 等のインフラに適している。

RFMD 社について: RFMD(NASDAQ: RFMD)社は移動通信の主要アプリケーション向けに高性能な無線システム/ソリューションの設計、製造を行う会社で、この業界のグローバル・リーダー。RFMD 社のパワーアンプ、送信モジュール、携帯電話用トランシーバ、およびシステム・オン・チップ(SOC)ソリューションは現在および次世代の携帯端末、基地局、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)、全地球測位システム(GPS)などの最新機能をサポートし、全世界的なモビリティの向上と接続性の拡大に寄与するもの。最先端の半導体技術による幅広い製品ラインと無線システムの豊富な経験で定評のある RFMD 社は、現在および将来の市場要求を満たす最新無線機能のサプライヤーとして、世界中の主要な移動通信機器メーカーから選ばれている。

ノースカロライナ州グリーンズボロに本社を置く RFMD 社は ISO 9001 および ISO 14001 の認証取得済みのメーカーで、世界各地にエンジニアリング、設計、販売、サービスの拠点を持つ。RFMD 社は RFMD 銘柄で米ナスダックグローバルセレクト市場に上場しています。なお詳しい情報は RFMD 社のホームページ、www.rfmd.com に紹介されている。

このプレス・リリースには、1995 年米国私募証券訴訟改革法 (*Private Securities Litigation Reform Act*) がその免責条項として定める「将来的な予測」が含まれています。この「将来的な予測」には当社の計画、目的、説明、主張などについて、またはそれ以外についての記述が含まれていますが、これらの記述は歴史的な事実ではなく、通常は「可能」、「必要」、「予測」、「期待」、「予定」、「計画」、「推測」、「確信」、「推定」、「予想」、「可能性」、「継続」などの用語や類似の用語とともに使用されています。またこれらとは別の表現で「将来的な予測」が記述される場合もあります。この文書に含まれている「将来的な予測」の記述は現時点における経営陣の判断や期待を表していますが、実際の成果や出来事、業績などはこれら記述で表現されたり暗示されたりした内容とは実質的に異なる場合もあります。当社は米国連邦証券取引法により要求される場合を除き、これら「将来的な予測」の記述内容を改訂したり、あるいはその記述の改訂を公表したりする意図を持っていません。RF マイクロデバイセス社の事業には多くのリスクや不確実性が内在しており、その内容には四半期毎の経営成果の変動、無線関連市場の発展や成長率、ウェハ製造施設、分子線エピタキシー施設、組み立て施設、試験、テープ、リール施設など各種製造施設の稼働に関するリスク、熟練技術者や開発リーダーを採用・確保する当社の能力、生産歩留りの変動、革新的技術によりコストを削減し正味利益率を改善する能力、新製品を市場に投入する能力、顧客の在庫センターを通して行う委託販売への依存性、製品需要に即応したタイムリーな生産能力の調整を行う能力、限られた顧客への依存性、サードパーティへの依存性などが含まれています。上記以外にも含むこれらリスクや不確実性については米国証券取引委員会の様式 10-K に従った RF マイクロデバイセス社の最新アニュアルレポートの中で説明されていますが、このような不確実性のため、これら記述の表現や暗示による内容と実際の成果や出来事、業績とは実質的に異なる場合があります。

RF MICRO DEVICES® および RFMD® は RFMD, LLC の商標である。その他の商品名、商標、登録商標はそれぞれその所有者の財産である。

###